

シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ  
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

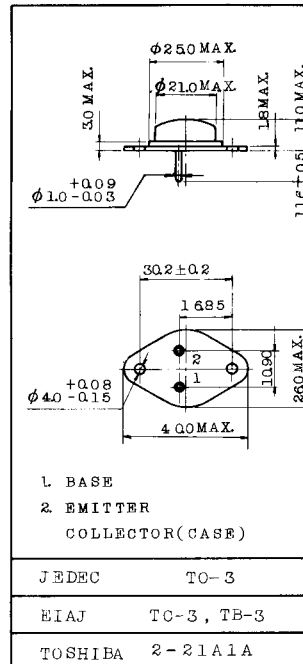
2SB557

- 電力増幅用
- Power Amplifier Applications
  - ・ コレクタ損失が大きい ;  $P_C = 80W$
  - ・ 高耐圧です ;  $V_{CE0} = -120V$
  - ・ 2SD427 とコンプリメンタリになります。
  - ・ 50W Hi-Fi オーディオアンプ出力段に最適です。
  - ・ Complementary to 2SD427
  - ・ Recommended for 50W High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage

最大定格 MAXIMUM RATINGS (  $T_a = 25^\circ C$  )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	-120	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	8	A
エミッタ電流	$I_E$	8	A
コレクタ損失	$P_C$	80	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{S Tg}$	-65 ~ 150	$^\circ C$

Unit in mm



アクセサリは AC 73 を使用  
MOUNTING KIT № AC 73

# 2SB557

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (  $T_a = 25^\circ\text{C}$  )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -60\text{V}, I_E = 0$	—	—	-100	$\mu\text{A}$
エミッタしや断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$	—	—	-100	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -0.1\text{A}, I_B = 0$	-120	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -10\text{mA}, I_C = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -1\text{A}$	40	—	140	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -5\text{A}$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -5\text{A}, I_B = -0.5\text{A}$	—	—	-2.5	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -5\text{A}$	—	—	-2.0	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -5\text{V}, I_E = 1\text{A}$	—	7	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0$ $f = 1\text{MHz}$	—	280	—	pF

Note ;  $h_{FE(1)}$  により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$ , the 2SB557 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SB557-R	40	80
2SB557-O	70	140